

Серия РС817 Оптопара для монтажа высокой плотности

- * Доступны в свинцовом форм факторе (тип I) и в виде бобины с лентой (тип P). (PC817I/PC817P)
- **Одобренный тип TÜV (VDE0884) также доступен опционально.

• Состав средств

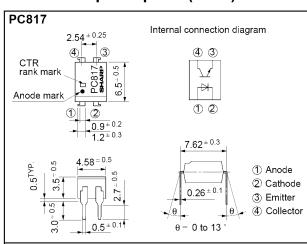
- 1. Коэффициент передачи по току (СТR: MIN 50% при I_F =5mA, V_{ce} = 5V)
- 2. Высокая изоляция напряжения между входом и выходом (V_{iso} : $5000V_{rms}$)
- 3. Компактная упаковка "два в линию"

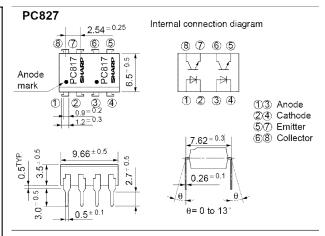
PC817: 1 канал **PC827**: 2 канала **PC837**: 3 канала **PC847**: 4 канала

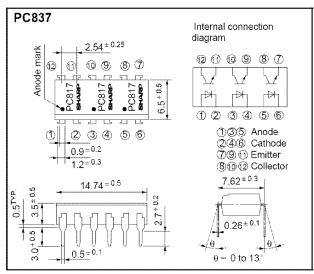
- 4. Признан лабораторией по технике безопасности (UL файл № E64380)
- Эскизы с размерами (в мм)

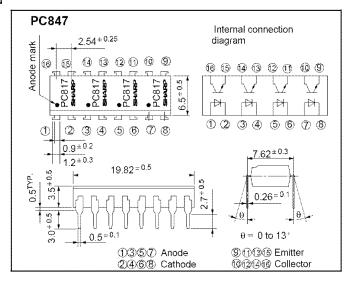
Применение

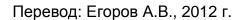
- 1. Компьютерные терминалы
- 2. Системные приборы, измерительный инструмент
- 3. Регистраторы, копировщики, торговые автоматы
- 4. Электроприборы домашнего применения, например тепловентилятор и т.д.
- 5. Передача сигнала между схемами с различными потенциалами и импедансом













■ Абсолютный максимум характеристик (T_a = 25 °C)

Параметр	Символ	Значение	Ед. изм.	
Вход	Прямой ток	I _F	50	mA
	Пиковый прямой ток ^{1*}	I _{FM}	1	Α
	Обратное напряжение	V_R	6	V
	Рассеяние мощности	Р	70	mW
Выход	Напряжение коллектор-эмиттер	V_{CEO}	35	V
	Напряжение эмиттер-коллектор	V_{ECO}	6	V
	Ток коллектора	I _C	50	mA
	Рассеяние мощности коллектора	P _C	150	mW
Общее рассеяние мощности		P _{tot}	200	mW
Напряжение изол	V_{ISO}	5000	V_{rms}	
Рабочая темпера	T _{opr}	-30 +100	°C	
Температура хра	T _{srg}	-55 +125	°C	
Температура пай	T _{sol}	260	°C	

^{1*} Импульсы шириной <= 100µs, Рабочий цикл: 0,001 2* от 40 до 60% RH, АС на 1 минуту

• Электро-оптические характеристики (T_a = 25°C)

Параметр		Символ	Условие	MIN	TYP	MAX	Ед. изм
Вход	Прямое напряжение	V _F	I _F = 20 mA	-	1.2	1.4	V
	Пиковое прямое напряжение	V_{FM}	I _{FM} = 0.5 A	-	-	3.0	V
	Обратный ток	I_R	$V_R = 4V$	-	-	10	μΑ
	Нагрузочная ёмкость	Ct	V = 0, f = 1 kHz	-	30	250	pF
Выход	темновой ток коллектора	I _{CEO}	V _{CE} = 20V	-	-	10 ⁻⁷	А
Характеристики передачи	Коэффициент передачи по току ^{4*}	CTR	$I_F = 5mA$, $V_{CE} = 5V$	50	-	600	%
	Напряжение насыщения коллектор- эмиттер	V _{CE(sat)}	$I_F = 20$ mA, $I_C = 1$ mA	-	0.1	0.2	V
	Сопротивление изоляции	R _{ISO}	DC500V, от 40 до 60% RH	5×10 ¹⁰	10 ¹¹	-	Ω
	Плавающая ёмкость	C _f	V = 0, f = 1 MHz	-	0.6	1.0	pF
	Частота среза	f _c	$V_{CE} = 5V$, $I_{C} = 2mA$, $R_{L} = 100\Omega$, -3dB	-	80	-	kHz
	Время отклика	рост t _r	$V_{CE} = 2V$, $I_C = 2mA$,	-	4	18	μs
×		спад t _f	$R_L = 100\Omega$	-	3	18	μs

^{4*} Классификационная таблица с этим параметром приведена ниже.

^{3*} для 10 секунд



№ модели	Метка	CTR (%)	
	коэффициента		
PC817A	Α	80 - 160	
PC817B	В	130 - 260	
PC817C	С	200 - 400	
PC817D	D	300 - 600	
PC8*7AB	А или В	80 - 260	
PC8*7BC	В или С	130 - 400	
PC8*7CD	С или D	200 - 600	
PC8*7AC	А,В или С	80 - 400	
PC8*7BD	В,С или D	130 - 600	
PC8*7AD	А,В,С или D	80 - 600	
PC8*7	А,В,С,D или	50 - 600	
	без метки		

^{* 1} или 2, или 3, или 4

Рисунок 1. Отношение прямого тока I_F к окружающей температуре T_a

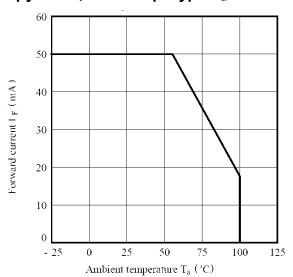
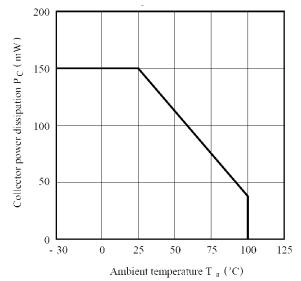
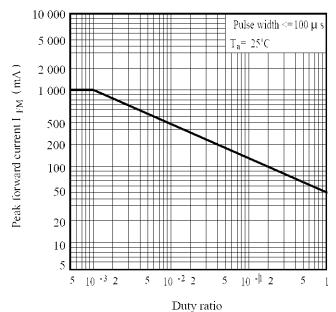


Рисунок 2. Отношение рассеяния мощности коллектора P_c к окружающей температуре T_a



я Рисунок 3. Отношение пикового прямого к тока I_{FM} к рабочему циклу





передачи по току СТР (%) к прямому прямому напряжению V_F току I_F

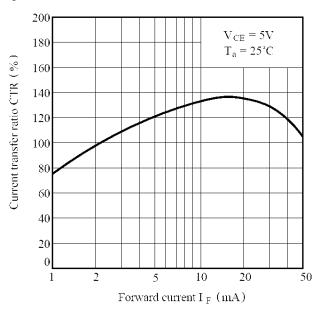


Рисунок 4. Отношение коэффициента Рисунок 5. Отношение прямого тока I_F к

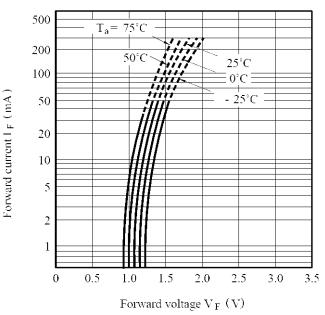


Рисунок 6. Отношение тока коллектора I_C к напряжению коллектор-эмиттер V_{CE}

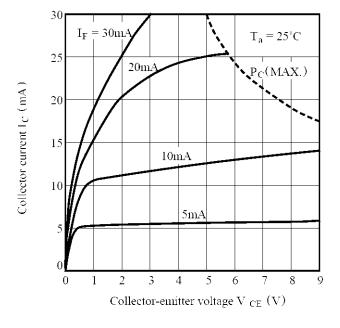
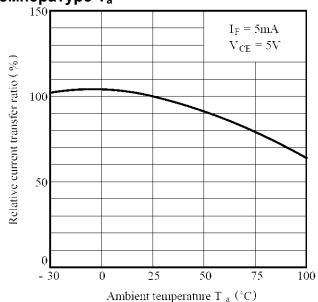


Рисунок 7. Отношение коэффициента передачи по току (%) к окружающей температуре Та



4



Рисунок 8. Отношение напряжения насыщения коллектор-эмиттер $V_{\text{CE(sat)}}$ к окружающей температуре T_a

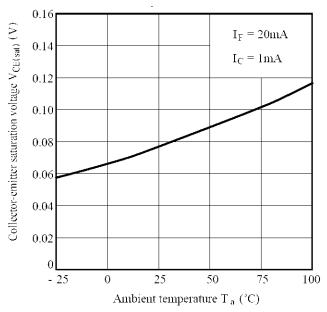


Рисунок 9. Отношение темнового тока коллектора I_{CEO} к окружающей температуре T_a

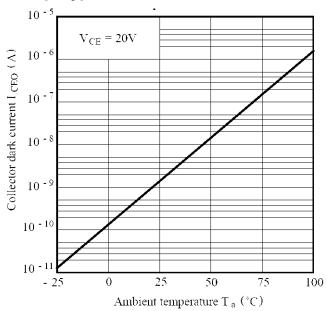


Рисунок 10. Отношение времени отклика (µs) к сопротивлению нагрузки R_L

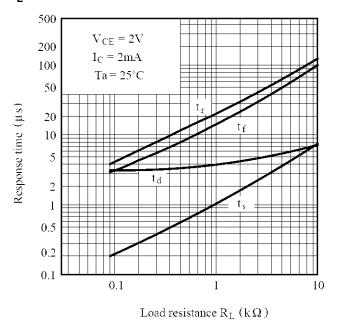


Рисунок 11. Частотная характеристика (отношение коэффициента усиления по напряжению A_V к частоте f)

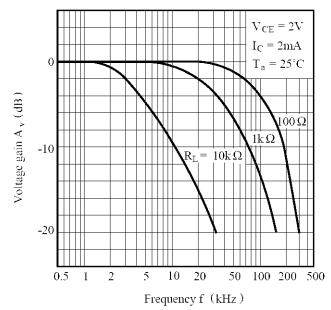
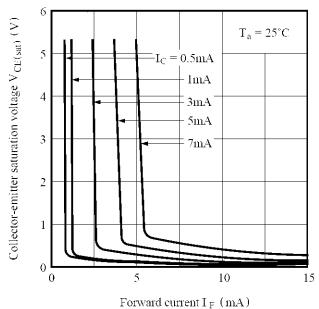
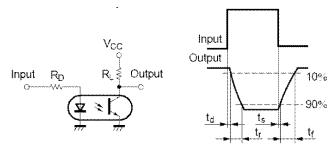




Рисунок 12. Отношение напряжения Тестовая схема насыщения коллектор-эмиттер $V_{\text{CE(sat)}}$ к времени отклика прямому току I_{F}



Тестовая схема для определения времени отклика



Тестовая схема для определения частотной характеристики

